Elektronik 2

FS 24 Guido Keel (Michael Lehmann)

Autoren:

Authors

Version: 1.0.20240221

https://github.com/P4ntomime/elektronik-2



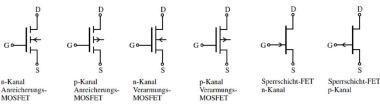
Inhaltsverzeichnis

1

Feldeffekt-Transistoren	2	1.3 MOS-FETs	-
1.1 FET-Typen und Symbole	2	1.4 Verstärkerschaltungen mit FETs	2
1.2 Sperrschicht-FET / Junction FET (JFET)	2	1.5 MOS-FET als Schalter	2

1 Feldeffekt-Transistoren

1.1 FET-Typen und Symbole

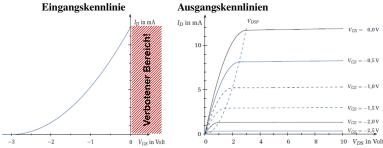


1.1.1 Anschlüsse eines FET

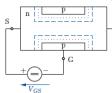
G Gate S Source D Drain В Bulk Kanal von Drain zu Source (Stromfluss), gesteuert von Gate (und Bulk)

1.2 Sperrschicht-FET / Junction FET (JFET)

1.2.1 Kennlinien



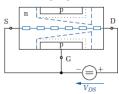
1.2.2 Linearer Bereich (gesteuerter Widerstand)



- V_{GS} ändert Dicke der Raumladungszone (Kanal)
- ullet n-Kanal JFET: Je negativer $V_{\scriptscriptstyle GS}$, desto weniger Strom fliesst bzw. desto enger der Kanal

$$I_D = rac{2 \cdot I_{\scriptscriptstyle DSS}}{V_{\scriptscriptstyle p}^2} \Big(V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle p} - rac{V_{\scriptscriptstyle DS}}{2} \Big) V_{\scriptscriptstyle DS}$$

1.2.3 Sättigungs-Bereich (Stromquelle)



- Für hohes V_{DS} wird leitender Kanal abgeschürt
- →Strom kann nicht weiter steigen (Stromquelle)
- Übergang gest. Widerstand zu Stromquelle @ $V_{\scriptscriptstyle DSP}$ $\Rightarrow V_{DSP} = V_{GS} - V_p (V_p = \text{Pinch-Off-Spannung})$

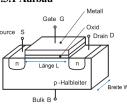
$$I_{\scriptscriptstyle D} = rac{I_{\scriptscriptstyle DSS}}{V_{\scriptscriptstyle p}^2} \cdot (V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle p})^2$$

Verstärkungsmass Transkonduktanz:

$$g_m = rac{2 \cdot I_{\scriptscriptstyle DSS}}{V_{\scriptscriptstyle o}^2} \cdot (V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle p}) = rac{2}{|V_{\scriptscriptstyle p}|} \cdot \sqrt{I_{\scriptscriptstyle DSS} \cdot I_{\scriptscriptstyle D}} \qquad [g_m] = \mathrm{S}$$

1.3 MOS-FETs

1.3.1 Aufbau

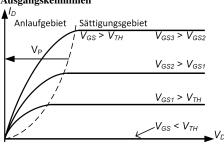


- Länge des Transistors L
- Breite des Transistors
- N-Kanal FET: Drain und Source sind n-dotiert
- Kanal ist p-dotiert

1.3.2 Kennlinien

Eingangskennlinie I_D

Ausgangskennlinien



1.3.3 Bereiche

- Sperrbereich: $V_{GS} < V_{TH}$
- Linearer (Widerstands-)Bereich / Anlaufbereich: $V_{\scriptscriptstyle GS} > V_{\scriptscriptstyle TH}$
- Sättigungsbereich (Stromquelle): $V_{\scriptscriptstyle DS} > V_{\scriptscriptstyle GS} V_{\scriptscriptstyle TH}$

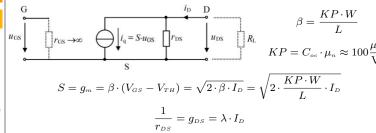
Anlaufbereich (Linearer Bereich)

Sättigungsbereich (Stromquelle)

$$I_{\scriptscriptstyle D,lin} = \beta \cdot (V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle TH} - \frac{V_{\scriptscriptstyle DS}}{2}) \cdot V_{\scriptscriptstyle DS} \qquad \qquad I_{\scriptscriptstyle D,sat} = \frac{\beta}{2} \cdot (V_{\scriptscriptstyle GS} - V_{\scriptscriptstyle TH})^2$$

$$I_{D,sat} = rac{eta}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TH})$$

1.3.4 Kleinsignal-Ersatzschaltung



1.4 Verstärkerschaltungen mit FETs

- 1.4.1 Source-Schaltung mit Lastwiderstand
- 1.4.2 Push-Pull / Digitaler Inverter

1.5 MOS-FET als Schalter